

4407

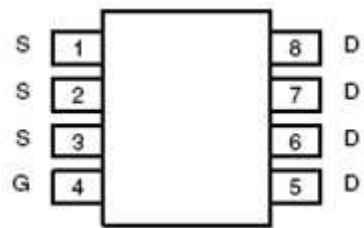
30V P 沟道增加型 MOS 场效应管

$V_{DS} = -30V$
 $R_{DS(ON)}, V_{GS}@-10V, I_{ds}@-7A = 12m\Omega@TYP$
 $R_{DS(ON)}, V_{GS}@-4.5V, I_{ds}@-5A = 17m\Omega@TYP$

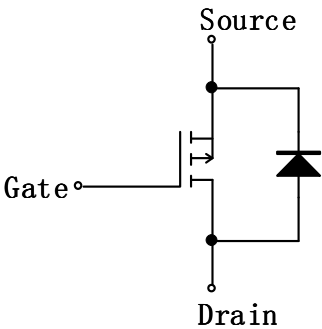
特点

- 高级的加工技术
- 极低的导通电阻高密度的单元设计
- 改良的成型工艺

封装图：SOP-8



内部结构示意图



P-Channel MOSFET

最大额定值和热特性 (T_A=25℃，除非另有说明。)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	-30	V
栅源电压	V_{GS}	±20	
漏极电流	I_D	-8	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	-30	
工作结温和存储温度范围	T_J, T_{stg}	-55 to 150	℃

注：重复性极限值：脉冲宽度由最高结温限制。

电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$	-30	--	--	V
漏源电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -4.5V, I_D = -5A$	--	17.0	22.0	mΩ
	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -10V, I_D = -7A$	--	12.0	17.0	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$	-1	-1.65	-3	V
栅源短路时漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS} = -24V, V_{GS} = 0V$	--	--	-1	uA
漏极短路时截止栅电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, I_{DS} = 0V$	--	--	±100	nA
栅极电阻	R_G	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 0V,$ Frequency=1MHZ	--	6	--	Ω
二极管正向电压	V_{SD}	$I_S = -8A, V_{GS} = 0V$	--	--	-1.3	V

注：1、脉冲测试：脉冲宽度<= 300us，占空比<= 2%

封装信息

